

Laserdiodi, 635nm, 20mW, halkaisija 5,6 mm

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8989

EAN13: -

HS-koodi: 90132000



Tuotteen parametrit:

Aallonpituus: 635-640 nm

Tapaus: TO-18

Kattavuus: IP20

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Laserdiodi, jonka aallonpituus on 635 nm ja teho 20 mW.

aallonpituus 635nm

jännite 2,3-2,6V

käänteinen jännite 10V

virta 75-85mA

suojaustaso IP20

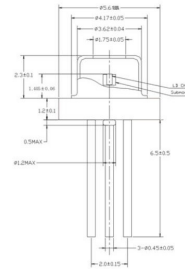
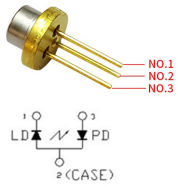
käyttölämpötila -10 - 50 °C

koko 5,6x5,6x10 mm

hinta 1 kpl

Pin määrittäminen: nasta nro 2 (kotelo) = ANODI, nasta nro 1 = LD-katodi, nasta nro 3 = PD-anodi

Galerie:



◆ ABSOLUTE MAXIMUM RATING at Tc=25 °C

Items	Symbols	Values	Unit
Optical Output Power	P	30	mW
Laser Diode Reverse Voltage	V	10	V
Photo Diode Reverse Voltage	V	30	V
Operating Temperature	T _{op}	-10 ~ 140	°C
Storage Temperature	T _{stg}	-40 ~ 140	°C

◆ ELECTRICAL and OPTICAL CHARACTERISTICS at Tc=25 °C

Items	Symbols	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Optical Output Power	P	-	20	-	mW	-
Threshold Current	I _t	-	80	80	mA	-
Operating Current	I _o	-	75	85	mA	For-Drive
Operating Voltage	V _o	-	2.5	2.6	V	For-Drive
Slant Efficiency	η _s	0.4	0.7	1.0	W/WMA	For-Drive
Leaking Wavelength	λ _s	624	628	644	nm	For-Drive
Beam Divergence	θ _{1/2}	5	5	12	mrad	For-Drive
Beam Divergence	θ _{1/2}	5	20	30	mrad	For-Drive
Beam Angle	Δθ _{1/2}	-3	-	3	mrad	For-Drive
Beam Current	I _b	-	3	-	mA	For-Drive
Monitor Current	I _m	0.1	0.2	0.4	mA	For-Drive
Optical Distance	ΔL, ΔV, ΔZ	-	1.80	-	mm	-